課題番号 : F-21-TT-0036

利用形態 :機器利用

利用課題名(日本語) : 高品質還元酸化グラフェンの作製のための還元手法の最適化

Program Title (English) : To check conductivity of graphene oxide films

利用者名(日本語) :<u>カニシカ デ シルバ</u> Username (English) : <u>Kanishka De Silva</u>

所属名(日本語) : 豊田工業大学表面化学研究室

Affiliation (English) : Toyota Technological Institute Surface Science Laboratory

キーワード/Keyword :リソグラフィ・露光・描画装置

1. 概要(Summary)

Conductive graphene oxide (GO) thin films were fabricated with different reduction conditions, such as chemical methods and thermal annealing. To measure the conductivity of these films, Cr/Au electrodes were fabricated using the photolithography method. For this, a mask was prepared in the cleanroom.

2. 実験(Experimental)

【利用した主な装置】

マスクレス露光装置、ズース、現像一式、レジストコータ【実験方法】

- ① マスクレス露光装置にてマスクを作製
- ② サンプルにレジストをスピンコート

条件: レジスト: AZ1400 4.4cp,

500 rpm, 10 s 3000 rom, 30 s

- ③ ズースに①で作製したマスクをセットし、試料に露光
- 4) 現象
- ⑤ 研究室内の装置でクロムと金をスパッタ
- ⑥ リフトオフ

3. 結果と考察(Results and Discussion)

Figure 1 shows the pattern on the sample (GO/SiO₂/Si) after doing photolithography using the prepared mask. After that, Cr/Au was sputtered to make electrodes and the photoresist was removed using acetone (shown in Figure 2).

I succeeded in making the electrodes and measured the conducting properties of the GO films.

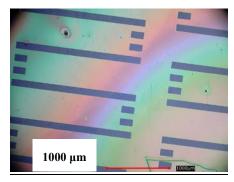


Figure 1. Pattern obtained from the mask on the sample after photolithography.

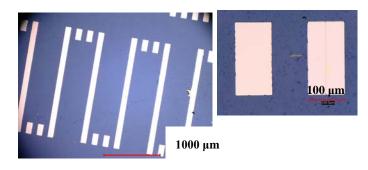


Figure 2. Pattern obtained from the mask on the sample after sputtering Cr/Au.

<u>4. その他・特記事項(Others)</u>

なし

5. 論文·学会発表(Publication/Presentation)

なし

6. 関連特許(Patent)

なし